# レーストラック型リング光共振器の設計と作製

田主 裕一朗 (COE研究員), 和気 勝 (先端研量子物質科学専攻 M2), 横山 新 (ナノデバイス・システム研究センター 教授, 先端研半導体集積科学専攻)

### 1. 研究目的

LSI の微細化に伴い金属配線による配線遅延が LSI の高速化を阻む最大の要因となっている。光配線 は配線遅延を克服する有力な手段である。

超小型(10µm オーダー)リング光共振器が可視光 や赤外光の波長フィルタとして利用できることが示され 注目されている[1]。波長フィルタは一本の光ファイバ ーまたは光導波路に多数の異なる波長の光を伝送し て大容量通信を実現する波長多重通信に不可欠な デバイスである。リング共振器は Si プロセスで作成可 能なのでチップ内光配線における集積型波長フィルタ として最適である。

Chu らはリングとバスライン導波路とを積層する積層 型リング共振器を開発した[2]。積層型の利点はリング とバスラインとの結合効率を間に挟まれるクラッド層の 厚さによって正確に制御できる点である。しかし、積層 型リング共振器はリングとバスラインとを同平面に作成 する平面型リング共振器よりも製造プロセスが複雑に なる。そこで我々は平面型レーストラックリング共振器 [3]を作製した。平面型真円リング共振器では結合効 率の制御が困難であることが最大の弱点であるが、レ ーストラック型では結合長を変化させることで結合効率 を正確に制御できる。

## 2. これまでの研究成果概要

レーストラック共振器の概略を Fig. 2 に示す。設計 パラメータはリング半径 R、結合長 L、およびギャップ g である。Input から入力した光の一部はギャップを通じ てリング内に移る。リングを一周したときに位相が元に 戻る波長を持った光がリング内で共振し、Output 2 に 強く出力されるので、共振波長は

$$\lambda_m = n_{eff} \, \frac{2\pi R + 2L}{m} \tag{1}$$

で与えられる。ここで*n*effは有効屈折率、*m*は任意の整数である。結合効率はギャップ*g*と結合長*L*で決まるが、リング内で光が共振可能な程度には大きくする必要がある。レーストラック型の利点はギャップを 0.2µm 程度に広く取っても結合長*L*を長くすれば結合効率を 十分に大きくすることができる点である。しかし、式(1) から共振波長間隔(FSR)はレーストラックの周長に反 比例するので、FSRを広く取るためには結合長*L*は短 いほうが良い。

Fig. 3(a)、(b)の二種類のレーストラック型リング共振 器を作製した。両者の違いは結合長の長さのみであり、 リングの周長およびリング半径は同一に設計した。ま ず、導波路幅を決定するために導波路の伝播損失の 幅依存性を有限差分法(FDM)でシミュレートした(Fig. 4)。シミュレータには Apollo Photonic Solutions Suite を用いた。幅 3µm とすれば光通信で用いられる波長 1.3µm 近傍での損失は十分小さくなることがわかった。 次に、リング半径を決めるために曲げ損失の曲げ半径 依存性をシミュレートした(Fig. 5)。FSR を広く取るため にはリング半径 R は短いほうが望ましいので、多少損 失は大きくなるがリング半径  $R \ge 10$ µm とした。

作製は Fig. 6 のように、電子ビームリソグラフィでパ ターンを作製し、反応性イオンエッチング(CF<sub>4</sub>+N<sub>2</sub> プラ ズマ)により窒化膜をエッチングした。狭いレジストギャ ップではエッチングレートが低下するので、ギャップ部 分では窒化膜は完全にエッチングされずギャップは不 完全となった。

Fig. 7は Fig. 3(a)のサンプルの共振特性の測定結 果である。二次元有限差分時間領域(2D-FDTD)シミュ レーションによる結果も示した。Output 1 のディップと Output 2 のピークが良く対応しており、シミュレーション による共振波長とも良く一致している。Fig. 3(a)と(b)の サンプルの Output 2 への出力測定を比較したのが Fig. 8 である。(a)のほうが結合長が長く結合効率が大きい ので Output 2 への出力が大きい。Fig. 9 は Output 2 への共振波長での出力の測定結果をシミュレーション 結果と比較したものである。シミュレーションではギャッ プが完全に形成されたと仮定しているので、測定結果 よりもサンプル間の出力差が大きくなっている。

# 3. まとめと今後の予定

レーストラック型リング光共振器の設計と製作を行い、 特性を評価した。シミュレーションと比較し、良く一致し ていることを確かめた。今後はさらに設計を最適化す るとともに、リングのコア材料に電気光学材料を用いた 光スイッチへ応用する。

### 参考文献

[1] B. E. Little et al., J. Lightwave Technol. 15 (1997) 198.

[2] S. T. Chu et al., Photon Technol. Lett. 11 (1998) 691.

[3] W. Lorattanaruangkit *et al.*, Proc. Asia-Pacific Microwave Conf. 1183 (2000).

## 4. これまでの研究発表

- Y. Tanushi, M. Wake and S. Yokoyama, "Race-Track Optical Ring Resonators with Groove Coupling", submitted to Int. Conf. on Solid State Devices and Materials (SSDM2004).
- Y. Tanushi, K. Wakushima and S. Yokoyama, "Very Small Optical Switch using Tunable Optical Ring Resonator Controlled by Electric Field", 応用物理学関 係連合講演会講演予稿集 (2004) 29a-ZC-9.
- Y. Tanushi, M. Wake, K. Wakushima, M. Suzuki and S. Yokoyama, "Technology for Ring Resonator Switches using Electro-Optic Materials", submitted to Int. Conf. on Group IV Photonics.





Fig. 1 Planar and Stack ring resonators. Planar resonator has simple structure and can be easily fabricated.

Fig. 2 Structure of race-track resonator. Device parameters are the ring radius R, the gap g, and the coupling length L. The resonating wavelength depends on R and L, and the coupling efficiency depends on g and L.





Fig. 3 SEM photographs of the fabricated two kinds of race-track resonators. The coupling length L is (a) 12.6  $\mu$ m and (b) 6.3  $\mu$ m respectively. The ring radius R is 10  $\mu$ m and the gaps are 0.2  $\mu$ m in both samples.



Fig. 4 Simulated propagation loss by FDM. The cross section of the waveguide is also shown.



Fig. 5 Simulated bending loss by FDM. The structure of the waveguide is the same as the one in Fig. 4



Fig. 6 Fabrication process of the race-track resonator. Silicon nitride film is deposited by plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) and SiO<sub>2</sub> cladding layer is thermally oxidized.



Fig. 7 Measured resonating property of the sample shown in Fig. 3(a). Simulated result is also shown. Simulation method is 2D FDTD.



Fig. 8 Comparison between the intensities of output 2 for the fabricated two kinds of samples shown in Figs. 3(a) and 3(b).



Fig. 9 Power of output 2 for samples (a) and (b) in Fig. 3. In the simulation it is assumed that the groove reaches to the bottom cladding layer.

